

イオンビーム工学セミナーのご案内

1. 日時 2016年3月4日(金)
2. 会場 法政大学小金井キャンパス
西館 W201
(JR 中央線東小金井駅北口下車徒歩 12 分)
3. プログラム
15:00~17:00
 - 「高誘電率絶縁膜を用いた高耐圧縦型 GaN ダイオード」
法政大学 吉野 理貴 氏
 - 「シリコンバイポーラと GaN デバイス」
法政大学 中村 徹 教授

事前のお申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

主催・問合せ先

法政大学イオンビーム工学研究所
〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2
TEL 042-387-6094 FAX 042-387-6095